

استان:

## کارشناسی (سترن)

تعداد سوالات: سنتی: ۲۰ تشریحی: ۴  
زمان آزمون (دقیقه): سنتی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

پیام نور  
خبرگزاری  
دانشجویان

**PNUNA.COM**  
PNU News Agency

مجاز است.



نام درس: فیزیک قطعات نیمه رسانا ۱  
رشته تحصیلی / گذاره درس: فیزیک (جامد) - ۱۱۱۳۰۳۸

استفاده از:

گذاره سوال: یک (۱)

امام خمینی (ره): این محروم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

۱. چگالی حالت‌های انرژی مجاز در نوار ظرفیت با کدام کمیت متناسب است؟

- الف.  $\sqrt{E_c - E}$ . د.  $\sqrt{E - E_v}$  ج.  $\sqrt{E - E_c}$  ب.  $\sqrt{E_v - E}$

۲. وجود اتم‌های بخشیده با چگالی  $N_d$  بیانگر چیست؟

الف. افزایش احتمال اشغال نوار در نوار ظرفیت

ب. تراکم الکترون‌ها در نوار رسانش از تراکم ذاتیش کمتر می‌شود.

ج. تراز فرمی از وسط کاف به طرف بالا منتقل می‌شود.

$$d. N_d = n + p$$

۳. در یک نیمرسانا  $a = \frac{I_n}{I_p}$  است. نسبت  $\frac{dn}{dp} = b$ ،  $\frac{D_n}{D_p} = c$  کدام است؟ ( $D$  ثابت پخش است)

- الف.  $\frac{-1}{ab}$  د.  $\frac{1}{ab}$  ج.  $-ab$  ب.  $ab$

۴. الکترونها در نیمرسانای تحت تأثیر میدان الکتریکی خارجی چگونه رفتار می‌کند؟

الف. با سرعت سوق میرا حرکت می‌کنند.

ب. مشابه حرکت الکترون‌ها در خلاء رفتار می‌کنند.

ج. به شتاب ثابت نمی‌رسند.

د. سرعت سوق الکترونها با میدان الکتریکی ضعیف رابطه نمایی دارند.

استان:

## کارشناسی (سترن)

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

پیام نور  
خبرگزاری دانشجویان  
**PNU.COM**  
PNU News Agency

مجاز است.



نام درس: فیزیک قطعات نیمه رسانا ۱

رشته تحصیلی / گذ درس: فیزیک (جامد) - ۱۱۱۳۰۳۸

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

۵. کدام گزینه درست است؟

الف. یک مرکز بازترکیب فقط الکترون را به دام می‌اندازد.

ب. کاستی‌های ناشی از تابش در سلول‌های خورشیدی تعداد مراکز بازترکیب را کاهش می‌دهند.

ج. کاستی‌های ناشی از تابش در سلول‌های خورشیدی کارایی سلول را افزایش می‌دهند.

د. مراکز بازترکیب معلول اتم‌های ناخالصی یا کاستی‌های شبکه بلور هستند.

۶. اگر آهنگ به دام افتادن الکترون توسط مرکز خالی  $R_1$ ، آهنگ گسیل الکترون به نوار رسانش  $R_p$ ، آهنگ به دام افتادن گسیل حفره‌ها توسط مراکز به ترتیب  $R_m$ ،  $R_e$  باشد تحت شرایط حالت پایا کدام رابطه برقرار است؟

$$R_1 + R_p = R_m + R_e \quad \text{ب.}$$

$$R_1 - R_p = R_m - R_e \quad \text{الف.}$$

$$R_1 R_p = R_m R_e \quad \text{د.}$$

$$R_1 + R_p = R_m - R_e \quad \text{ج.}$$

۷. با افزایش تزریق:

الف.  $E_i$  به سمت  $E_{fp}$  نزدیک می‌شود.

ج. تفاضل  $E_{fn} - E_i$  با  $p$  افزایش می‌یابد.

۸. کدام گزینه درست است؟

الف. در اتصال پیش ولت مخالف، سد پتانسیل کاهش می‌یابد.

ب. ترازهای فرمی وار مستقل از چگالی حامل هستند.

ج. در اثر شارش جریان تحت پیش ولت مخالف،  $\varphi_n$ ،  $\varphi_p$  متغیر خواهد بود.

د. شکافتگی ترازهای فرمی وار بیانگر حاملهای اضافی در نواحی خنثای نزدیک به ناحیه تهی است.

استان:

## کارشناسی (سترن)

تعداد سوالات: سنتی: ۲۰ تشریحی: ۴  
زمان آزمون (دقیقه): سنتی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

پیام نور  
خبرگزاری دانشجویان

**PNUA.COM**  
PNU News Agency

مجاز است.



نام درس: فیزیک قطعات نیمه رسانا ۱

رشته تحصیلی / گذار درس: فیزیک (جامد) - ۱۱۱۳۰۳۸

استفاده از:

گذار سوال: یک (۱)

۹. در یک نیمرسانا طول عمر حامل اقلیتی برابر  $\frac{cm^3}{s}$  و ثابت پخش الکترون ها برابر  $۲۸/۶$  می باشد، طول پخش الکترون کدام است؟

- الف.  $cm^{۱/۲} \times ۱۰^{-۴}$       د.  $cm^{۴/۶} \times ۱۰^{-۳}$       ج.  $cm^{۵/۳} \times ۱۰^{-۳}$       ب.  $cm^{۱/۸} \times ۱۰^{-۳}$

۱۰. مقدار  $qA \int_0^W U dx$  بیانگر چیست؟

- الف. جریان بازترکیب      ب. جریان حامل اقلیتی      ج. جریان تولید در ناحیه خنثی      د. جریان اشباع

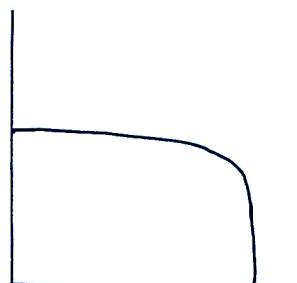
۱۱. اگر  $C$  ظرفیت گذار یا ظرفیت لایه تهی باشد با توجه به سیگنال کم دامنه لایه بارفضایی،  $C'$  با کدام کمیت متناسب است

- الف.  $\frac{1}{A^2}$       ن.  $N_d$       ج.  $V_R - \psi_0$       ب.  $V_R + \psi_0$

۱۲. بار انباشته در حالت پایایی وضعیت پیش ولت موافق برابر است با:

- الف.  $\sqrt{I_f \tau_p}$       ن.  $\frac{\tau_p}{I_f}$       ج.  $\frac{I_f}{\tau_p}$       ب.  $I_f \tau_p$

۱۳. نمودار مقابل بیانگر چیست؟



الف. تغییرات ثابت جذب بر حسب طول موج

ب. مشخصه جریان - ولتاژ باتری خورشیدی

ج. سد پتانسیل پیوندگاه  $p - n$

د. شکست در  $JFET$

۱۴. با توجه به توان خروجی باتری خورشیدی کدام گزینه درست است؟

الف. با افزایش  $E_g$ ,  $E_L$  افزایش می یابد.

د. جریان اشباع معکوس مستقل از دما است.

ج.  $V_{oc}$  با جریان اشباع معکوس نسبت مستقیم دارد.

## کارشناسی (ستم)

استان:

تعداد سوالات: سنتی: ۲۰ تشریحی: ۴  
زمان آزمون (دقیقه): سنتی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

پیام نور  
خبرگزاری  
دانشجویان

**PNUA.COM**  
PNU News Agency

مجاز است.



نام درس: فیزیک قطعات نیمه رسانا ۱

رشته تحصیلی / گذ درس: فیزیک (جامد) - ۱۱۱۳۰۳۸

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

۱۵. سازو کار تابندگی الکترولومینسانس دارای چه طول موج گسیلی است؟

- الف. فرابینفش      ب. پرتو  $X$       ج. مرئی و رادیوئی      د. مرئی و فروسرخ

۱۶. در یک  $JFET$  عرض لایه بار فضایی در کدام ناحیه با عرض کانال برابر است؟

- الف. ناحیه اشباع      ب. طرف  $p$       ج. طرف  $n$       د. نقطه تنگش

۱۷. در یک  $LED$ :

الف. گستره  $n$  بین ۵/۱ تا ۳ قرار دارد.

ب.  $\theta_c$  بین  $۳۰^\circ$  تا  $۴۵^\circ$  می باشد.

ج. کاهش  $\alpha$  باتولید لومینسانی با  $h\nu < E_g$  عملی است.

د. نسبت  $\frac{V}{A}$  دو برابر عمق پیوندگاه  $x_j$  از سطح گسیلنده است.

۱۸. در یک  $JFET$  مقدار ولتاژ شکست  $V_B$  برابر است با:

- الف.  $V_{DO} + V_G$       ب.  $V_D + V_G + V_P$       ج.  $V_{DO} - V_G$       د.  $\frac{V_{DO} - V_G}{V_P}$

۱۹. بهره جریان گسیلنده - مشترک کدام است؟

- الف.  $\frac{\alpha}{1-\alpha}$       ب.  $\frac{1}{1+\alpha}$       ج.  $\frac{1}{1-\alpha}$       د.  $\frac{1}{1+\alpha}$

۲۰. اگر  $x_B$  دو برابر شود زمان لازم برای عبور الکترون از پایه در یک ترانزیستور ( $\tau_B$ ) چند برابر می شود؟

- الف. دو برابر      ب. چهار برابر      ج.  $\frac{1}{2}$       د.  $\frac{1}{4}$

## کارشناسی (سترن)

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

پیام نور  
خبرگزاری دانشجویان

**PNUNA.COM**  
PNU News Agency

مجاز است.



نام درس: فیزیک قطعات نیمه رسانا ۱

رشته تحصیلی / گذ درس: فیزیک (جامد) - ۱۱۱۳۰۳۸

استفاده از:

گذ سری سوال: یک (۱)

### سؤالات تشریحی

(بارم هر سوال ۱/۷۵ نمره می باشد)

۱. یک قرص سیلیسیم با  $10^{16}$  اتم بور و  $10^{16}$  اتم فسفر آلاییده شده است. تراکم‌های الکترون و حفره  $E_f$  و مقاومت ویژه رادر دمای اتاق ( $300^\circ K$ ) محاسبه کنید.
۲. بازترکیب سطحی را با روابط توضیح دهید.
۳. شکست بهمنی در پیوندگاه  $n-p$  را با روابط بیان کنید.
۴. ساختار  $JFET$  کانال  $n$  سیلیسیمی دارای پارامترهای زیر است.  
مطلوب است محاسبه : (الف) پتانسیل داخلی  $\psi$  (ب) رسانایی  $G$ .